

## SD 335 ... SD 340 □

SD 335/337/339 npn-, SD 336/338/340 pnp-Silizium-Epitaxie-Planar-Transistoren mittlerer Leistung für allgemeine NF-Anwendungen.

Als komplementäre Transistorpaare sind sie für NF-Leistungsendstufen und für Treiberstufen in NF-Verstärkern mit hohen Ausgangsleistungen verwendbar.

Bauform 6 TO126

Wärmewiderstand  $R_{thja} \leq 110 \text{ K/W}$   
 $R_{thjc} \leq 10 \text{ K/W}$

**Grenzwerte:** (gültig für den Betriebstemperaturbereich)

	SD 335/336	337/338	339/340	
$ U_{CBO} $	45	60	80	V
$ U_{CEO} $	45	60	80	V
$ U_{EBO} $		5		V
$ I_C $		1,5		A
$ I_{CM} $		2		A
$ I_B $		0,2		A
$P_{tot} (\vartheta_c \leq 25^\circ\text{C})$		12,5		W
$P_{tot} (\vartheta_a \leq 40^\circ\text{C})$		1		W
$\vartheta_j$		150		$^\circ\text{C}$
$\vartheta_a$		-55 ... +125		$^\circ\text{C}$

**Statische Kennwerte** ( $\vartheta_a = 25^\circ\text{C} - 5 \text{ K}$ )

	SD 335/337/339			SD 336/338/340		
	min	typ	max	min	typ	max
$ U_{(BR)CBO}  ( I_C  = 1 \text{ mA})$						
SD 335/336	45			45		V
SD 337/338	60			60		V
SD 339/340	80			80		V
$ U_{(BR)CEO}  ( I_C  = 50 \text{ mA})$						
SD 335/336	45			45		V
SD 337/338	60			60		V
SD 339/340	80			80		V
$ U_{(BR)EBO}  ( I_E  = 1 \mu\text{A})$	5			5		V
$ I_{CBO}  ( U_{CB}  = 30 \text{ V})$	< 1	100		< 10	100	nA
$ I_{EBO}  ( U_{EB}  = 5 \text{ V})$	< 5 nA	10 $\mu\text{A}$		< 5 nA	10 $\mu\text{A}$	
$ U_{CEsat} ^{(1)} ( I_C  = 500 \text{ mA},  I_B  = 50 \text{ mA})$		200	500	280		500 mV
$ I_C  = 100 \text{ mA},  I_B  = 10 \text{ mA})$		70		80		mV
$ U_{BEsat} ^{(1)} ( I_C  = 500 \text{ mA},  I_E  = 50 \text{ mA})$		870		930		mV